論文内容の要旨

論文題目 A Study on Design and Implementation of

Two-Dimensional MOSFET Neuron Model

(MOSFETを用いた2次元ニューロンモデルの設計と

実装に関する研究)

氏名 竹本 享史

1. はじめに

脳の優れた情報処理能力を工学的な応用に生かすことは脳科学の大きな目標であり、脳型情報処理シ ステムの構成理論とそのハードウェア化の基盤技術の確立を目指す上で、神経細胞の機能を模倣した電 子回路を設計することは重要である.従来の設計方法としては、生体神経の特定の性質に着目して、同 様の性質を再現する Phenomenological design と、神経膜のイオンチャネルのダイナミクスを可能な限 り忠実に再現する Conductance-based design の2種類が知られている.最近、電子回路ニューロンの 設計に位相解析や分岐解析といった数理的手法を取り入れた Mathematical-model-based design が提案 された(Kohno *et al.*, 2005).この方法では、ハードウェアの特性を効率よく取り込んだ回路設計が可 能なため、生物ニューロンに近く、しかも回路規模が小さいニューロン回路が実現できる.

本論文では,Mathematical-model-based design に従い、ニューロンを2変数の単純な位相構造で表 現した MOSFET による電子回路ニューロンモデルを提案する.Hodgkin によると、発火特性の違いから生 物ニューロンはクラス I・クラス II の2つのクラスに分類される.提案する回路は、数個の回路パラ メータを変更することで、クラス I、狭いチャンネルと呼ばれる位相構造を持つクラス I*、クラス II など様々なタイプのニューロンモデルを実現できる.本モデルの個別部品による実装を行い、提案回路 が生体ニューロンの持つ性質を正しく継承していることを理論・実験の両面から評価した.また数値計 算によって、本回路をギャップジャンクションで結合した場合、あるパラメータ領域で様々な時空間カ オスが生じることを確認した.

2. MOSFETを用いた電子回路ニューロンの設計

ニューロンのクラスの分類は、モデルの次元に依存しない概念であるが、2 変数モデルで議論できる ことが知られている.ここでは数理的に扱いやすいこの2 変数縮約モデルに議論を限定する.2 変数縮 約モデルは、膜電位 V と(縮約された)不活性化変数 µ で表現され、その力学的挙動はこの2 変数のナ ルクラインによって特徴付けられる.多くの場合、V のナルクラインは(V, µ)の相空間上で逆 N 型とな り、一方、µのナルクラインはクラス | ニューロンで U 型であり、クラス II ニューロンでは直線的に なる.クラス | ニューロンの中に、発火の閾値近傍で、相空間の2 つのナルクラインの間に狭いチャン ネルと呼ばれる幾何構造が出現されるものがあり、これはクラス |*と呼ばれる(Fujii *et al.*, 2004).

提案する2次元ニューロンモデルは、標準的なCMOSプロセスで集積回路化可能なエンハンスメント型 MOSFETを用いて設計する.使用するMOSFETの多くは、低消費電力・数理モデル構築の容易さなどの利点から、ドレイン電流がゲート電圧に対し、指数関数的な依存性を持つサブスレッショルド領域で動

作させる.図1に、電子回路ニューロンモデルのブロック 図を示す.本モデルは逆N型非線形回路(図2)・U型非線 形回路(図3)・線形性の良い電圧電流(V-I)変換器の3つの 主要回路を組み合わせることで実現する.各回路ブロック の出力電流が入力電圧に対して陽に関数で書き出せること は、数理的な解析を容易にする.この電子回路ニューロン の回路方程式は以下のように書ける.

$$\begin{cases} C_{v} \frac{dV}{dt} = f(V) - k\mu + I_{stit} \\ C_{\mu} \frac{d\mu}{dt} = g(V) - \frac{\mu}{R_{\mu}} \end{cases}$$

ここで、電圧 V は膜電位、電圧 μ は不活性化変数を表現し、 kは V-I 変換器の変換係数、f(V)とg(V)はそれぞれ、逆 N 型非線形回路とU型非線形回路の出力電流を示す.各非線 形回路は、主に differential pair、CS-Amplifier、VI 変 換器で実現し、その入出力特性は抵抗値を変えることによ って容易に変更できる設計とした.この柔軟性によって、本 モデルは様々なタイプのニューロンモデルを実現できる.本 論文では、本回路が数個の回路パラメータの変更のみで、 (1)J型の μ のナルクラインを持つクラス I、(2)U型の μ の ナルクラインを持つクラス I*、(3)I型の μ のナルクライン を持つクラス IIの 3 モードを実現できることを示す.

ニューロンのクラスの分類は、数理的な見地からは、クラ



図1:電子回路ニューロンのブロック図.



図 2: 逆 N 型非線形回路.



図3:U型非線形回路.

スIではサドル・ノード分岐、クラス II ではサブクリティカルホップ分岐という異なる反復スパイク 発生機構に反映することが知られている(Ermentrout *et al.*, 1989). 各モードにおける分岐構造の違 いは、分岐解析ソフト XPPAUT を用いて確認し、提案回路がクラスI・クラス II の発火特性機構を実現 していることを確認した.

3. 提案回路の個別部品を用いた実装と動作特性

提案回路を互いにコンプリ(特性の揃ったN型P型FET)である個別部品(2SK1133/2SJ166)を用いて実装し、動作特性の検証を行った. 図4に提案回路の位相構造例を示す.各モードにおける回路パラメ ータは、理論モデルの位相構造と類似するように設定した.

過去の電子回路ニューロンの研究では、実装した回路の動作測定 について、あまり詳細な数理的解析が行われていない.設計したニ ューロン回路が生体ニューロンの性質を再現できることを確認する ために、(a)神経興奮の特徴、(b)クラスI,クラスIIの異なるスパイ ク発生機構、(c)クラスIIにおける周期刺激に対するカオス的応答、 の3つの性質について検証した.

(a)の神経興奮の条件は、静止状態・閾値・活動電位・不応期の 存在よって特徴付けられる(Zeeman, 1972).この性質は、単発刺激・ 2 重刺激を電子回路ニューロンに与えることで確かめることができ る 図5にクラスIモードにおける単発刺激に対する応答例を示す. 単発刺激の強度がある値を越えると、突然高いピーク値を持った活 動電位が観測され、これは閾値の存在を示唆している.また2重刺 激を与えることで、不応期の存在や、不応期から提案回路が回復す る様子も観測された.同様な特性はクラスI*・クラスIIでも観測さ れた.

次に(b)のニューロンの発火特性の違いは、分岐パラメータとみ なした定常電流を提案回路に与えることで観測できる.入力電流を 大きくしていくと、提案回路はある閾値において周期発火を生じ、 クラス I・I*モードではその開始時の発火周波数が非常に低いのに 対し、クラス II では非常に高い頻度で発火することが確認できた.

ヤリイカの巨大軸索や Hodgk in-Hux ley 方程式のようなクラス II のモデルに、周期刺激を与えると、あるパラメータ領域で、カオス 的な応答が得られることが知られている.単純な入力に対するこ のような複雑な応答が、脳の符号化に関して重要な役割を果たし ている可能性が指摘されている.提案回路に周期刺激を与えたと ころ、ある領域で図6に示すような非周期的な応答が観測された. 各刺激パルスの立下り付近で、この時系列をサンプリングし、リ ターンプロットを取ると、図7に示すようなはっきりとした曲線 が現れた.従ってこの非周期的応答はランダムなものではなく、 決定論的なものであると考えられる.また Lyapunov 指数を見積も ったところ、1.589±0.004 と正の値が得られた.よって、この非 周期的な応答はカオスであることが示唆される.



図 4:提案回路の µ-V 位相構造 . 点線が理 論値、実践が実験値 . 赤線が V ナルクラ イン、緑線、青線、水色線がそれぞれ、ク ラス I、I*、II の R ナルクラインを示す .



対する応答.





以上の実験結果から、提案する電子回路ニューロンモデルが、生物ニューロンの特性をよく再現して いることが確かめられた.

4.1次元ギャップジャンクション結合系における時空間カオス的挙動

近年、大脳新皮質における抑制性細胞間において、膨大な量のギャップジャンクション(GJ)と呼ばれ る電気結合が報告され、GJ で結合された系が脳の符号化・情報表現に果たしている機能的役割について 注目が集まっている.Fujiiらは class I*ニューロンを GJ で結合すると、あるパラメータ領域で時空 間カオスパターンが生じると報告している.今回、提案回路を1次元的に20個並べ、互いに隣の細胞 と GJ 結合を持った空間的配置を考え、各モードにおけるシステムレベルの挙動を数値計算により検証 した.結合の強度はすべて一様とし、また GJ による電気結合は線形抵抗で表現した.

図 8-10 に、各モードにおける結合強度と最大リアプノフ指数の関係を示す.図に示すように、ネットワークの挙動は結合強度に依存して変化する.クラス I*モードでは、他のモードに比べ、非常に高い 最大リアプノフ指数を示す領域が、広い範囲で存在することがわかる.この領域では、時刻0における 各コンデンサーのわずかな電荷の違いが、時刻が進むにつれて、やがて時空間カオス的な挙動へと移行 する過程が観測される.



図 8:クラス I*モードにおける最大 Lyapunov 指数と結合強度の関係 .



図 9:クラス I モードにおける最大 Lyapunov 指数と結合強度の関係

観測されるカオスパターンの中には、全同期した状態と非同期の 状態の遷移を不規則に繰り返す挙動も見られた(図 11).このような 現象は、Fujiiらの研究でも観測され、大脳新皮質のダイナミクス の研究に新たな側面を切り開く可能性がある.またこの現象は、擬 アトラクター間を遷移するカオス的遍歴として数学的に理解できる 可能性があるが(I. Tsuda *et al.*, 2004)、高次元系における時空 カオスは複雑であり、さらなる理論研究が必要である.



図 11:GJ 結合系で観測された全同期と非 同期のカオス的な遷移

5. 結論

本研究では数理的手法を回路設計に導入することで、MOSFET によりコンパクトに実装できる、生物ニューロンに近い性質を持つ2次元ニューロンモデルを提案した 本モデルを個別部品により実装し、 生体ニューロンの持つ性質を正しく再現していることを確認した.また、数値計算によってギャップジャンクション結合系での時空カオスを確認した.